

# Silicon Diode

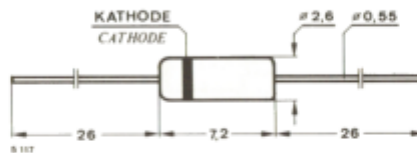
## **1N484A**

130V / 200mA

# DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1977

**1N484A****Silizium-Diffusions-Diode**  
**Silicon diffusion diode****Anwendungen:** Allgemein**Applications:** General purposes**Abmessungen in mm**  
**Dimensions in mm**

Normgehäuse  
Case  
51 A 2 DIN 41880  
JEDEC DO 7  
Gewicht · Weight  
max. 0,3 g

**Absolute Grenzdaten**  
**Absolute maximum ratings**

Periodische Spitzensperrspannung <i>Repetitive peak reverse voltage</i>	$U_{RRM}$	150	V
Sperrspannung <i>Reverse voltage</i>	$U_R$	130	V
Stoßdurchlaßstrom <i>Surge forward current</i> $t_p \leq 1 \text{ ms}$	$I_{FSM}$	2	A
Periodischer Durchlaßspitzenstrom <i>Repetitive peak forward current</i>	$I_{FRM}$	650	mA
Durchlaßstrom <i>Forward current</i>	$I_F$	200	mA
Verlustleistung <i>Power dissipation</i> $l = 5 \text{ mm}, t_L = 45^\circ\text{C}$	$P_V$	250	mW
Sperrschichttemperatur <i>Junction temperature</i>	$t_j$	175	°C
Lagerungstemperaturbereich <i>Storage temperature range</i>	$t_{stg}$	-55...+175	°C

# 1 N 484 A

---

## Kenngrößen Characteristics

Min. Typ. Max.

$t_j = 25^\circ\text{C}$ , falls nicht anders angegeben  
unless otherwise specified

Durchlaßspannung

Forward voltage

$I_F = 100\text{ mA}$

$U_F$

1

V

Sperrstrom

Reverse current

$U_R = 125\text{ V}$

$U_R = 125\text{ V}$ ,  $t_j = 150^\circ\text{C}$

$I_R$

25

nA

$I_R$

15

$\mu\text{A}$

Durchbruchspannung

Breakdown voltage

$I_R = 100\ \mu\text{A}$

$U_{(BR)}$

150

V

Diodenkapazität

Diode capacitance

$U_R = 10\text{ V}$ ,  $f = 0,5\text{ MHz}$

$C_D$

3

pF